



MD 2154 C2 2003.04.30

REPUBLICA MOLDOVA



(19) Agenția de Stat
pentru Protecția Proprietății Industriale

(11) **2154** (13) **C2**
(51) **Int. Cl.⁷**: G 01 N 27/00

(12) **BREVET DE INVENȚIE**

(21) Nr. depozit: a 2001 0362 (22) Data depozit: 2001.11.07	(45) Data publicării hotărârii de acordare a brevetului: 2003.04.30, BOPI nr. 4/2003
(71) Solicitant: DOROGAN Valerian, MD (72) Inventatori: DOROGAN Valerian, MD; KOROTCHENKOV Ghenadii, MD; VIERU Tatiana, MD; PRODAN Ion, MD (73) Titular: DOROGAN Valerian, MD	

(54) **Senzor de gaze**

(57) **Rezumat:**

1
Invenția se referă la senzori de gaze pe baza
peliculelor din metalo-oxizi (SnO_2 , In_2O_3 , etc.) care
se pot utiliza pentru controlul mediului ambiant, in
sistemele antiincendiare etc.

Senzorul de gaze include un substrat izolator, un
strat activ, un strat rezistiv cu contacte ohmice.

5
10

2
Stratul rezistiv are două sau mai multe regiuni cu
rezistențe diferite, iar pe stratul activ se confec-
ționează două sau mai multe perechi de contacte
ohmice.

Revendicări: 1
Figuri: 1

MD 2154 C2 2003.04.30

MD 2154 C2 2003.04.30

3

Descriere:

Invenția se referă la senzori de gaze pe baza peliculelor din metalo-oxizi (SnO_2 , In_2O_3 etc.) și poate fi utilizată pentru confecționarea detectoarelor de gaze poluante folosite pentru controlul mediului ambiant, în sisteme antiincendiar etc.

5 Sunt cunoscuți senzori de gaze pe baza semiconductorilor poroși (Si, GaAs, GaN) [1]. Dezavantajul senzorilor pe baza semiconductorilor poroși constă în fiabilitatea joasă, cauzată de degradarea suprafeței structurii poroase sub acțiunea factorilor externi și termici.

10 În calitate de cel mai apropiat analog a fost luat senzorul de gaze pe baza peliculelor din SnO_2 [2]. Dezavantajul acestui senzor constă în faptul că el nu poate detecta concomitent două sau mai multe gaze, deoarece sensibilitatea maximă la diferite gaze se realizează la diferite temperaturi.

Problema pe care o rezolvă invenția este crearea unui senzor de gaze pentru detectarea concomitentă a două sau mai multe gaze.

15 Senzorul de gaze conform invenției include un substrat izolator, un strat activ, un strat rezistiv cu contacte ohmice. Stratul rezistiv are două sau mai multe regiuni cu rezistențe diferite, iar pe stratul activ se confecționează două sau mai multe perechi de contacte ohmice.

Rezultatul constă în crearea temperaturilor de lucru necesare, pe diferite regiuni ale stratului activ ale senzorului de gaze cu ajutorul unei singure tensiuni de alimentare.

20 La aplicarea unei tensiuni de alimentare asupra stratului rezistiv, ce formează microîncălzitorul, pe regiunile cu diferită rezistență, conform relației $P=I^2R$, se degajă sub formă de căldură puteri diferite. În așa mod, în regiunile stratului activ se asigură temperaturile necesare pentru detectarea concomitentă a diverselor gaze.

25 Invenția se explică prin desenul din figura 1, care reprezintă structura și metoda de conectare a senzorului de gaze. Structura senzorului constă din substrat dielectric 1 cu termoconductibilitate înaltă; strat activ 2 sensibil la gaze; strat rezistiv 3, format din două sau mai multe regiuni cu rezistență diferită, care constituie microîncălzitorul; o pereche de contacte ohmice 4 pe stratul rezistiv, la care se aplică tensiunea de alimentare U_{alim} ; două sau mai multe perechi de contacte ohmice 5 pe stratul activ, la care se conectează rezistențele de sarcină R_{S1} , R_{S2} ,... R_{SN} . Deoarece rezistența microîncălzitorului pe domeniile I, II,...N este diferită $R_1>R_2>...R_N$ (grosimea stratului rezistiv este diferită), la aplicarea tensiunii de alimentare U_{alim} , temperaturile în regiunile sus-numite vor fi diferite $T_1>T_2>...T_N$. Rezistențele (grosimea) peliculei rezistive în domeniile I, II,...N se calculează în așa mod ca să se asigure temperaturile de lucru preconizate.

30 În continuare se dă un exemplu de realizare a invenției. Pe un substrat dielectric cu termoconductibilitate înaltă (SiO_2 , Al_2O_3 etc.) 1, prin metoda pirolizei compușilor metaloorganici se formează o peliculă din SnO_2 , care la diferite temperaturi își schimbă rezistența în prezența diferitor gaze. Pe partea verso a substratului 1, prin evaporare termică în vid, se depune un strat de material rezistiv (nicrom) cu diferite grosimi în domeniile I, II...N. Contactele ohmice pe partea frontală 5 și pe verso 4 se formează la fel prin evaporare termică în vid a metalelor Ni+Au.

40

MD 2154 C2 2003.04.30

4

(57) Revendicare:

Senzor de gaze, care include un substrat izolator, un strat activ, un strat rezistiv cu contacte ohmice, **caracterizat prin aceea că** stratul rezistiv are două sau mai multe regiuni cu rezistențe diferite, iar pe stratul activ se confecționează două sau mai multe perechi de contacte ohmice.

5

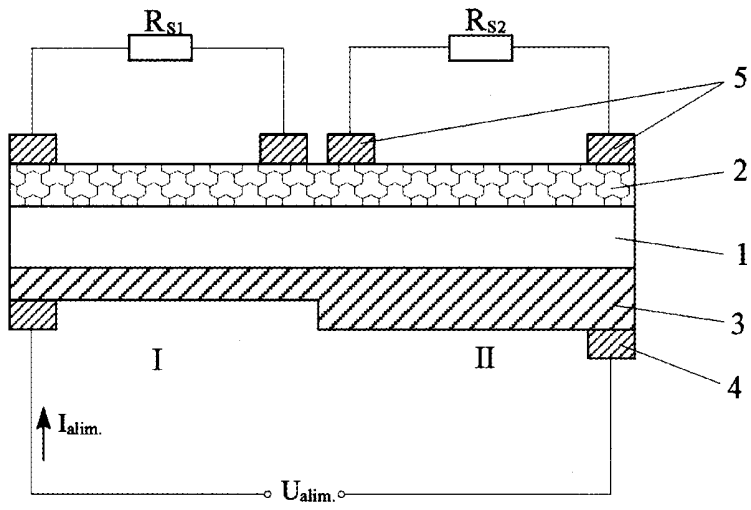
(56) Referințe bibliografice:

1. Michael S. Shur, M. Asif Khan. GaAs/AlGaIn Heterostructure Devices: Photodetectors and Field-Effect Transistors. MRS BULLETIN, February 1997, p. 44-50
2. G. S. Korotchenkov, S. V. Dmitriev, V. I. Brynzari. Processes development for low cost and low power consuming SnO₂ thin film gas sensor. International Journal Devoted to Research and Development of Physical and Chemical Transducers. Sensors and Actuators, B 54, 1999, p. 202- 209

Șef Secție:	COZMA Valeriu
Examinator:	COJOCARU Ala
Redactor:	LOZOVANU Maria

MD 2154 C2 2003.04.30

5



RAPORT DE DOCUMENTARE

(21) Nr. depozit: a 2001 0362	(85) Data fazei naționale PCT:	
(22) Data depozit: 2001.11.07	(86) Cerere internațională PCT:	
<p>Prioritatea invocată :</p> <p>(31) nr.: (32) data : (33) țara :</p> <p>(51)⁷ : G 01 N 27/00</p> <p>Alți indici de clasificare:</p> <p>(54) Titlul : Senzor de gaze</p> <p>(71) Solicitantul : DOROGAN Valerian, MD</p> <p>Termeni caracteristici :</p> <p>a) limba română: senzor de gas</p> <p>b) limba engleză: gas sensor</p>		
I. Minimul de documente consultate (sistema clasificării și indici de clasificare Int. Cl.- 7)		
Int. Cl. ⁷ G01N 27/00		
II. Literatura tehnico-științifică consultată adăugător la minim de documentație (autori, titluri, editura, țara și data publicării)		
<p>1. Michael S. Shur, M. Asif Khan. GaAs/AlGaN Heterostructure Devices: Phodetectors and Field – Effect Transistors. MRS BULLETIN, February 1997., p. 44-50.</p> <p>2. G. S. Korotchenkov, S. V. Dmitriev, V. I. Brynzari. Processes development for low power consuming SnO₂ thin film gas sensor. International Journal Devoted to Research and Development of Physical and Chemical Transducers. Sensors and Actuators, B 54, 1999, p. 202-209.</p>		
III. Baze de date electronice consultate (denumirea BD și termen de documentare)		
MD, perioada 1994-2002 BD Espacenet	EA, perioada 1996-2002 SU, perioada 1984-1994	
IV. Documente considerate ca relevante		
Categoria*	Date de identificare ale documentelor citate si indicarea pasajelor pertinente	Numărul revendicării vizate
A	1. Michael S. Shur, M. Asif Khan. GaAs/AlGaN Heterostructure Devices: Phodetectors and Field –Effect Transistors. MRS BULLETIN, February 1997., p. 44-50.	1
A	2. G. S. Korotchenkov, S. V. Dmitriev, V. I. Brynzari. Processes development for low power consuming SnO ₂ thin film gas sensor. International Journal Devoted to Research and Development of Physical and Chemical Transducers. Sensors and Actuators, B 54, 1999, p. 202-209.	1
<input type="checkbox"/> Documentele următoare sunt indicate în rubrica IV		<input type="checkbox"/> Informația referitoare la brevete paralele se anexează
* categoriile speciale ale documentelor consultate:		P - document publicat înainte de data depozit, dar după data priorității invocate

A - document care definește stadiul anterior general	T - document publicat după data depozitului sau a priorității invocate, care nu aparține stadiului pertinent al tehnicii, dar care este citat pentru a pune în evidență principiul sau teoria pe care se bazează invenția
E - document anterior dar publicat la data depozit național reglementar sau după aceasta data	X - document de relevanță deosebită: invenția revendicată nu poate fi considerată nouă sau implicând activitate inventivă când documentul este luat de unul singur
L - document care poate pune în discuție data priorității invocate sau poate contribui la determinarea datei publicării altor divulgări sau pentru un motiv expres (se va indica motivul)	Y - document de relevanță deosebită: invenția revendicată nu poate fi considerată ca implicând activitate inventivă când documentul este asociat cu unul sau mai multe alte documente de aceeași natură, aceasta combinație fiind evidentă pentru o persoană de specialitate
O - document referitor la o divulgare orală, un act de folosire, la o expunere sau orice altă divulgare	& - document care face parte din aceeași familie de documente
Data finalizării documentării	04.02.03
Examinatorul	Cojocaru Ala

RAPORT DE DOCUMENTARE

Informația referitoare la brevete paralele		(21) Nr. depozit:	
Date de identificare ale documentelor citate în raport	Data publicării	Brevete paralele	Data publicării
1	2	3	4